

Rys. 1-1125. SSY20

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-planarny *n-p-n* w obudowie metalowej, kolektor połączony z obudową, ciężar około 0,5 G

Zastosowanie: układy szybko przełączające dla maszyn do przetwarzania danych

Typy podobne: BSY34 (Sie), BSW26 (Int), BSY69 (Tel), BSX59÷61 (Ph), 2N2218 (Int, Ses, Tex, Four, Ph), KSY34 (Tesla)

Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	max		
I_{CBO}		200	nA	przy $U_{CB} = 50$ V
I_{CBO}		100	μ A	przy $U_{CB} = 60$ V
$U_{(BR)EBO}$	5		V	przy $I_E = 100$ μ A
$U_{(BR)CEO}$	40		V	przy $I_C = 10$ mA
$U_{CE sat}$		1,0	V	przy $I_B = 50$ mA, $I_C = 500$ mA
$U_{BE sat}$		1,5	V	przy $I_B = 50$ mA, $I_C = 500$ mA
h_{21E} (U)	8	22		} przy $I_C = 500$ mA, $U_{CE} = 1,3$ V
(A)	18	35		
(B)	28	71		
(C)	56	140		
t_{ON}		50	ns	} przy $I_C = 500$ mA, $I_{B1} = 50$ mA, $-I_{B2} = 25$ mA, $R_L = 80$ Ω
t_{OFF}		100	ns	

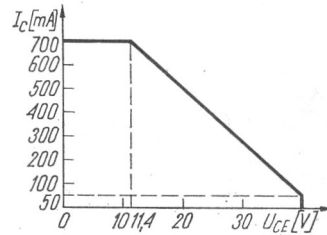
¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C} (-5^\circ\text{C})$

SSY20

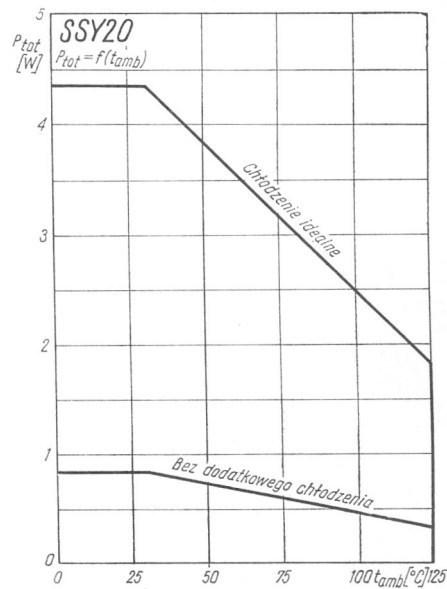
Wartości graniczne

$U_{CE0 \max}$	60	V
$U_{CE0 \max}$	40	V
$U_{EB0 \max}$	5	V
$I_C \max$	600	mA
$I_{CM \max}$	700	mA
$I_B \max$	100	mA
$P_{tot \max}$	700 ²⁾	mW
$t_j \max$	+175	°C
t_{amb}	-40 ÷ +125	°C
$R_{thj-a \max}$	0,22	°C/mW
$R_{thj-c \max}$	0,04	°C/mW

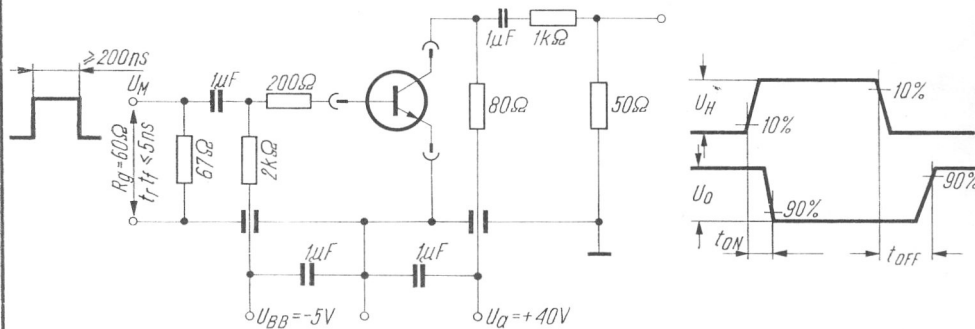
2) $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$



Rys. 1-1126. Dopuszczalny zakres pracy



Rys. 1-1128. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



Rys. 1-1127. Układ pomiarowy czasów przełączania